

Module photovoltaïque HIT

HIP-215NKHE5 HIP-214NKHE5

La cellule solaire SANYO HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer) se compose d'une fine plaque de silicium mono-cristallin enrobée dans des couches de silicium amorphe ultra-fines. Ce procédé de fabrication, conçu d'après les techniques les plus modernes, permet d'obtenir les performances les plus élevées du marché.



Une productivité élevée

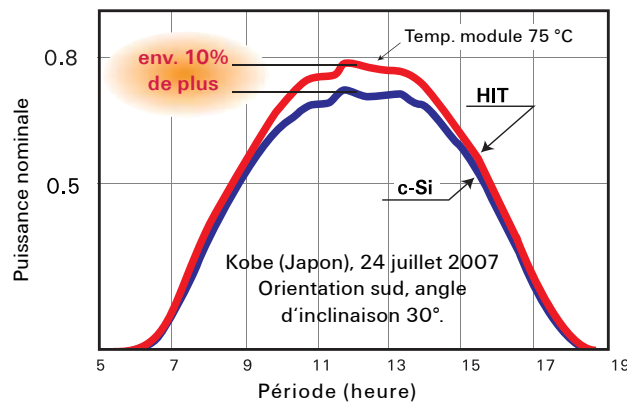
Les cellules et modules HIT ont l'un des rendements les plus élevés au monde en ce qui concerne la production de série.

Modèle	Rendement de la cellule	Rendement du module
HIP-215NKHE5	19,3%	17,1%
HIP-214NKHE5	19,2%	17,0%

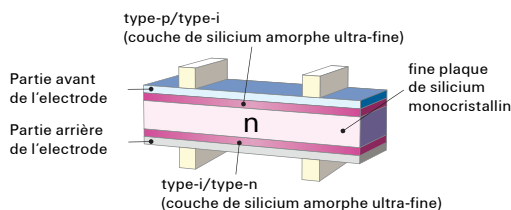
Une productivité élevée à hautes températures

A la différence d'une cellule solaire classique en silicium cristallin, la cellule solaire HIT peut produire avec un rendement important même à des températures élevées.

[Variation de la puissance produite au cours d'une journée]



Structure de la Cellule Solaire HIT



Le développement de la cellule solaire HIT a été partiellement financé par l'Organisation pour le Développement des Energies Nouvelles et des Technologies Industrielles (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO).

La cellule solaire respectueuse de l'environnement Plus d'énergie propre

Les cellules HIT délivrent une puissance de sortie au m² supérieure aux cellules solaires classiques en silicium cristallin.

Un module utilisant les ressources du silicium au maximum.

La nouvelle disposition en forme de nid d'abeille "Honeycomb Design" permet une disposition optimum et compacte des cellules pour un niveau de performance encore plus élevé.

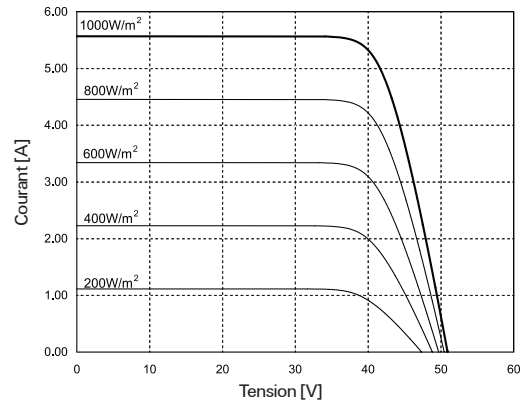
Cellule type ronde, haute performance (silicium) surface: 216 cm²
HIT-HD
cellule actuelle HIT

Données électriques	Modèles HIP-xxxNKHE5	
	215	214
Puissance maximum (Pmax) [W]	215	214
Tension de crête maximale (Vpm) [V]	42,0	41,9
Courant de crête maximale (Ipm) [A]	5,13	5,12
Tension en circuit ouvert (Voc) [V]	51,6	51,5
Courant de court circuit (Isc) [A]	5,61	5,60
Puissance minimum garantie (Pmin) [W]	204,3	203,3
Protection max. par surintensité inverse [A]	15	
Tolérance de puissance de sortie [%]	+10/-5	
Tension maximum de système [Vdc]	1000	
Coefficient de température de Pmax [%/°C]	-0,30	
Coefficient de température de Voc [V/°C]	-0,129	-0,129
Coefficient de température de Isc [mA/°C]	1,68	1,68
NOCT [°C]	48,0	

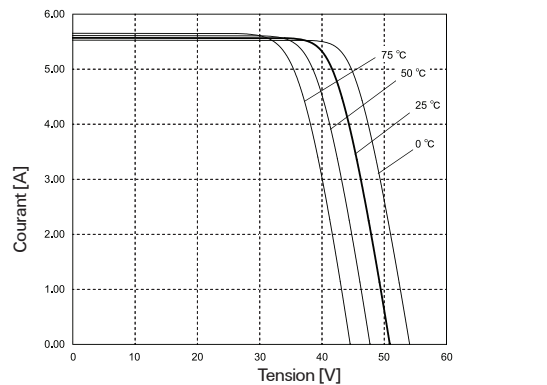
Note 1: Conditions standards de test: masse d'air 1,5; irradiance = 1000 W/m²,
Température de cellule = 25 °C
Note 2 : Les valeurs du tableau ci-dessus sont nominales.

Valeurs de référence pour le modèle HIP-215NKHE5

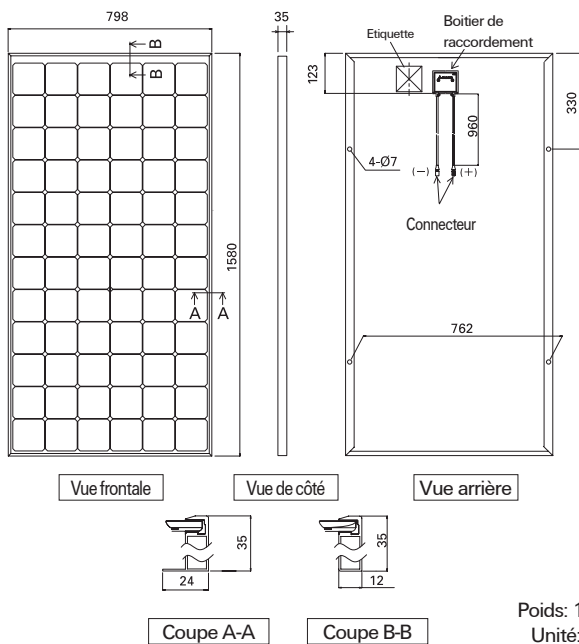
Variations en fonction de l'intensité d'irradiation



Variations en fonction de la température



Dimensions et poids



Certificats

IEC 61730 IEC 61215 ed. 2



Electrical Protection Class II

Veuillez consulter votre revendeur local pour toute information complémentaire.

Garanties

Produit: 5 ans

Performance: 10 ans (90% de Pmin), 20 ans (80% de Pmin)

Conditions détaillées disponibles sur notre site.

ATTENTION! Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant la mise en oeuvre des produits.

Dans le cadre de l'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute modification technique.

SANYO Component Europe GmbH
Solar Division

Stahlgruberring 4
81829 Munich, Germany
Tel.+49-(0)89-460095-0
Fax.+49-(0)89-460095-170
<http://www.sanyo-solar.eu>
email: info.solar@sanyo-solar.eu

SANYO Electric Co., Ltd.
Solar Division

<http://www.sanyo.com/solar>
email: homepage_solar@sanyo.com